



**КТ668А, КТ668Б, КТ668В**

**Кремниевые усилительные р-п-р транзисторы средней мощности**

Типовое значение граничной частоты передачи тока  $f_{ГП} = 200$  МГц  
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора  $P_{кmax} = 500$  мВт  
Максимальное постоянное напряжение коллектор-база  $U_{КБmax} = 50$  В

Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса
КТ668А, КТ668Б, КТ668В	аА0.336.717 ТУ	КТ-26 (ТО-92)

Кремниевые планарно - эпитаксиальные усилительные р-п-р транзисторы с нормированным коэффициентом шума в пластмассовом корпусе с гибкими выводами типа КТ668 могут применяться в усилительных, генераторных и переключающих устройствах аппаратуры широкого применения.

Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям аА0.336.717 ТУ.  
Размеры кристалла 0,5 x 0,5 мм.

**Схема расположения выводов  
КТ668А, КТ668Б, КТ668В**



- 1 - Эмиттер
- 2 - База
- 3 - Коллектор

**КТ-26**

**Основные электрические параметры в диапазоне рабочих температур: 0°C ÷ + 85°C**

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	КТ668 по группам		
		А	Б	В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 2$ мА не менее не более	$h_{21Э}$	75 140	125 250	220 475
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 10$ мА, $f = 100$ МГц не менее	$ h_{21Э} $	2		
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 0,5$ мА не более	$U_{КЭнас}$	0,3		
Коэффициент шума на $f = 1$ кГц, дБ при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_К = 0,2$ мА, $R_Г = 2$ кОм не более	$K_{ш}$	10		
Обратный ток коллектора, нА при $U_{КБ} = 30$ В не более	$I_{КБО}$	15		
Обратный ток эмиттера, нА при $U_{ЭБ} = 5$ В не более	$I_{ЭБО}$	100		
Емкость коллекторного перехода, пФ при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 10$ МГц не более	$C_К$	7		



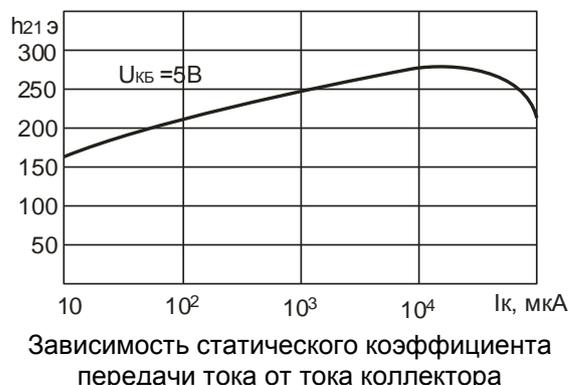
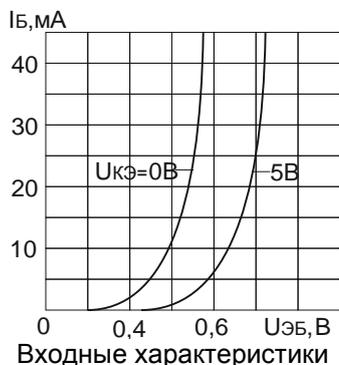
### Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	Примечания
		KT668A, KT668Б, KT668В	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\ max}$	50	1
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $I_K=2\ \text{мА}$ , $R_{БЭ}=\infty$ , В	$U_{КЭ0\ max}$	45	1
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\ max}$	5	1
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{К\ max}$	100	1
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, мА	$I_{КИ\ max}$	200	1
Максимально допустимый постоянный ток базы, мА	$I_{Б\ max}$	50	1
Максимально допустимая рассеиваемая мощность коллектора, мВт до $T=+25\ ^\circ\text{C}$	$P_{К\ max}$	500	2
Максимально допустимая температура перехода, $^\circ\text{C}$	$T_{П\ max}$	150	
Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Т\ п-с}$	250	

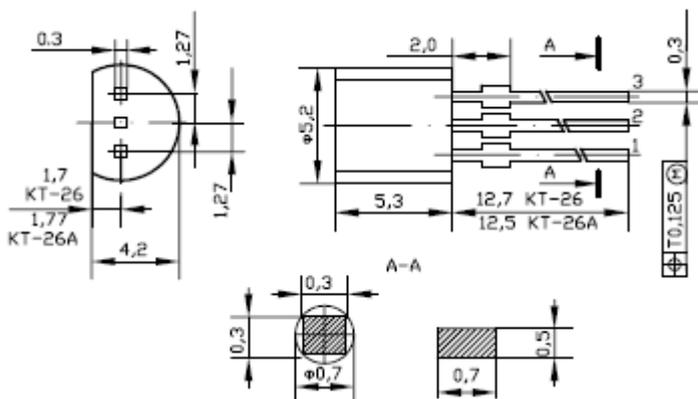
Примечания:

- 1) При условии неперевышения  $P_{К\ max}$ .
- 2) При температуре окружающей среды до  $+25\ ^\circ\text{C}$ . При температуре выше  $+25\ ^\circ\text{C}$   $P_{К\ max}$  рассчитывается по формуле:  $P_{К\ max} = (150 - T_{окр.ср}) / R_{Т\ п-с}$ , Вт.

### Основные типовые зависимости параметров транзисторов



### Габаритные чертежи используемых корпусов



- 1 - Коллектор
  - 2 - База
  - 3 - Эмиттер
- Допускается отсутствие выступов на выводах. Позиционный допуск на расстоянии 2,0 мм max.

Корпус КТ-26